

## Сапфир (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)



**Производитель:**

АО «Диполь Технологии»

**Цена:**

Цена по запросу

### Описание

Сапфир представляет собой многофункциональный кристаллический материал с превосходными свойствами: хорошей термостабильностью, высокой теплопроводностью, высокой твердостью, высоким коэффициентом пропускания в инфракрасном диапазоне длин волн, малым значением диэлектрической проницаемости и высокой химической и термической стойкостью.

### Применение

В качестве подложек интегральных микросхем, оптоэлектроники, микроэлектроники сапфир даёт возможность решить задачи повышения надёжности и стабильности параметров электронных устройств при работе в

жёстких условиях эксплуатации (инертность, радиационная стойкость, высокие и низкие температуры, высокие механические нагрузки, ионизирующие излучения и другие).

Подложки используются для эпитаксии полупроводниковых плёнок (Si, GaN, AlGaN и многих других).

## Спецификация

Сапфир (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	
Материал	Сапфир Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (≥99.996%)
Диаметр	50.8±0.1 мм, 100±0.1 мм, 150±0.2 мм
Толщина	420~440 мкм, 640-660 мкм, 1300 мкм
TTV	≤5 мкм
BOW	0~10 мкм
Warp	≤15 мкм
Шероховатость рабочей стороны	≤ 0.2 нм
LTV	≤1.8 мкм
Шероховатость обратной стороны	0.8-1.2 мкм
Лазерная маркировка	На задней стороне

Производство: Китай. Также доступны слитки, эпитаксиальные структуры и паттернированные подложки сапфира.